

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-204282
 (43)Date of publication of application : 09.08.1996

(51)Int.CI. H01S 3/18

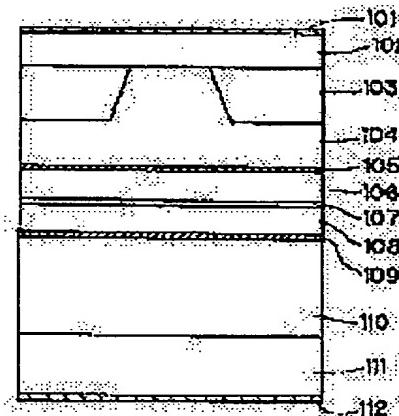
(21)Application number : 07-023339 (71)Applicant : NEC CORP
 (22)Date of filing : 19.01.1995 (72)Inventor : UENO YOSHIYASU
 SAWANO HIROYUKI
 TOMITA AKIHISA

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the active layer of a semiconductor laser which is provided with a saturable absorption layer for self-exciting vibrations from being deteriorated in light confining factor and to prevent the light beam emitted from the laser from being deformed in shape due to the introduction of the saturable absorption layer.

CONSTITUTION: Saturable absorption layers 105 and 109 are respectively provided at positions within 200nm from active layers in clad layers on both sides of an active layer 107. Namely, an n-type AlGaN_xP clad layer 110, n-type AlGaN_xP saturable absorption layer 109, n-type AlGaN_xP clad layer 108 having a film thickness of 100nm, AlGaN_xP active layer 107, p-type AlGaN_xP clad layer 106 having a film thickness of 100nm, p-type AlGaN_xP saturable absorption layer 105, p-type AlGaN_xP clad layer 104 are successively grown on an n-type GaAs substrate 1 and the clad layer 104 is machined to the shape of Chinese character 'projecting portion'. Then an n-type block layer 103 is formed so as to surround the projecting portion-shaped projecting section and a p-type contact layer 102 is formed on the layer 103.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]	19.01.1995
[Date of sending the examiner's decision of rejection]	
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]	
[Date of final disposal for application]	
[Patent number]	2814943
[Date of registration]	14.08.1998
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]	
[Date of extinction of right]	

Copyright (C) 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-204282

(43)公開日 平成8年(1996)8月9日

(51)Int.Cl.*

識別記号 庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H01S 3/18

審査請求 有 請求項の数5 FD (全8頁)

(21)出願番号 特願平7-23339

(22)出願日 平成7年(1995)1月19日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 上野 芳康

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72)発明者 沢野 博之

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72)発明者 富田 章久

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

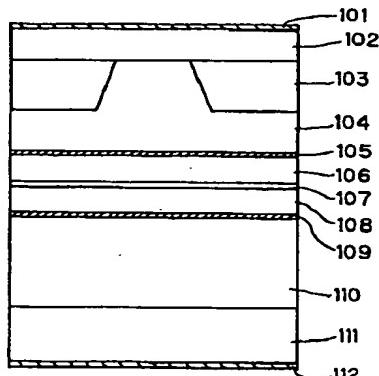
(74)代理人 弁理士 尾身 祐助

(54)【発明の名称】 半導体レーザ

(57)【要約】

【目的】 可飽和吸収層を備え自励振動を行わせるレーザにおいて、可飽和吸収層を導入したことによって、活性層の光閉じ込め係数が低下したり、光ビーム形状が歪んだりすることのないようにする。

【構成】 活性層107の両側のクラッド層内の活性層から200nm以内の位置に可飽和吸収層105、109を設ける。即ち、n型GaAs基板111上に、n型AlGaInPクラッド層110、n型AlGaInP可飽和吸収層109、膜厚100nmのn型AlGaInPクラッド層108、AlGaInP活性層107、膜厚100nmのp型AlGaInPクラッド層106、p型AlGaInP可飽和吸収層105、p型AlGaInPクラッド層104、を成長させ、クラッド層104を“凸”字形状に加工し、その凸起部を囲むようにn型電流ブロック層103を形成し、さらにp型コントラクト層102を形成する。



101…p側電極

102…p型GaAsコンタクト層

103…n型GaAs電流ブロック層

104…p型AlGaInPクラッド層

105…p型AlGaInP可飽和吸収層

106…p型AlGaInPクラッド層

107…AlGaInP活性層

108…n型AlGaInPクラッド層

109…n型AlGaInP可飽和吸収層

110…n型AlGaInPクラッド層

111…n型GaAs基板

112…n側電極

(2)

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1導電型の半導体基板上に第1導電型の第1のクラッド層、第1導電型の可飽和吸収層、第1導電型の第2のクラッド層、活性層、第2導電型の第1のクラッド層、第2導電型の可飽和吸収層、第2導電型の第2のクラッド層、第2導電型のコンタクト層がこの順に形成されていることを特徴とする半導体レーザ。

【請求項2】 前記第2導電型の第2のクラッド層が、ストライプ状または断面形状が“凸”字状であることを特徴とする請求項1記載の半導体レーザ。

【請求項3】 第1導電型の半導体基板上に第1導電型のクラッド層、活性層、第2導電型の第1のクラッド層、第2導電型の可飽和吸収層、断面形状が“凸”字状である第2導電型の第2のクラッド層、第2導電型のコンタクト層がこの順に形成され、前記第2導電型の第2のクラッド層の凸起部が第1導電型の電流ブロック層に挿まれていることを特徴とする半導体レーザ。

【請求項4】 前記第1導電型の第2のクラッド層および前記第2導電型の第1のクラッド層、または、前記第2導電型の第1のクラッド層の膜厚が200nm以下であることを特徴とする請求項1または3記載の半導体レーザ。

【請求項5】 前記第1導電型の半導体基板がGaAsまたはGaAsPにより構成され、前記活性層がAlGaInPまたはAlGaInPAsにより構成されていることを特徴とする請求項1または3記載の半導体レーザ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、半導体レーザに関し、特に、情報処理機器の光源などに用いられる半導体レーザに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 近年、赤色AlGaInP半導体レーザの実用化が進み、高密度光ディスク装置などの光源として期待されている。半導体レーザの出射光を光ディスク上に集光して情報を再生する際、反射光の一部が半導体レーザの共振器内部に戻るためにレーザ光にいわゆる戻り光雑音が発生し、再生信号のC/N比(キャリアノイズ比)が悪化してしまうことが知られている。このC/N比の悪化を抑制するための手法として、従来より、高周波重疊法と自励振動(パルセーション)法が用いられてきた。

【0003】 前者は、半導体レーザの駆動電流に高周波電流を重疊する方法であって、高周波重疊を行うことにより、レーザ光のコヒーレンシを低減させ、戻り光によるレーザ雑音を抑制するものである。しかし、この方法では、高周波重疊を行うために、+10dBm程度と比較的高出力で200~700MHzと比較的高周波な駆動電流を発生させなければならず、これに必要な高周波

電流発生回路のコストや容積が光ディスク装置の低コスト化やコンパクト化に対する大きな阻害要因となる。さらに、高周波電流発生回路が装置外部へ高周波電磁波を放射するため、電磁障害を起こすという問題も生じる。

【0004】 一方、パルセーションレーザは、内部に可飽和吸収領域を持ち、この可飽和吸収領域のキャリアと活性層のキャリアと発振光が協同して自励振動(パルセーション)を引き起こすものである。自励振動状態の発振光のコヒーレンシは低いので、戻り光によるレーザ雑音が発生しにくくなる。この方式では、上述の高周波電流発生回路を使って高周波重疊を行なう必要がなく、外部へ放射される高周波電磁波も極めて少ない。以下、パルセーションレーザの従来技術について説明する。

【0005】 パルセーションレーザを実現するため、いくつかの可飽和吸収構造が報告されている。足立らは、活性層のうち電流注入領域に隣接する領域が可飽和吸収領域として働く構造を報告した(第55回応用物理学会学術講演会講演予稿集No.3, p.939, 20p-s-15, 1994年9月)【報告された構造は、図1(d)のものから可飽和活性層5を除去したものに相当する】。このレーザ構造では、クラッド層残り厚をエッチング工程で厳密に制御する必要がある。また、横方向の等価屈折率差(Δn)を小さくする必要がある。足立らの報告では、 Δn の値はおよそ 3×10^{-3} と小さい。

【0006】 一方、後藤らと松本らは、クラッド層内部に可飽和吸収層を設けた半導体レーザのパルセーション動作を報告した(第41回応用物理学関係連合講演会講演予稿集No.3, p.990, 28p-K-9, 1994年3月、および、第55回応用物理学会学術講演会講演予稿集No.3, p.933, 20a-S-6, 1994年9月)。この構造は、図1(d)に示すように、半導体基板11上に、クラッド層8、活性層7、クラッド層6、可飽和吸収層5、リッジ状のクラッド層4とそれを囲む電流ブロック層3、コンタクト層2を積層し、コンタクト層2上に第1電極1を、また半導体基板11下に第2電極12を設けたものである。

【0007】 このレーザ構造では、クラッド層4をリッジ状に加工する際に、可飽和吸収層5がエッチングストップの役目を果たしているため、エッチング工程での厳格な管理は必要ではなくなり、主要な構造パラメータとなる可飽和吸収層の組成と層厚を、制御性に優れた結晶成長装置で制御することができる。また、横方向等価屈折率差を小さくする必要がない。従って、前述の足立らのレーザ構造に比べて高い製造歩留り、高い基本横モード制御性、良好なレーザ光ビーム品質を得ることができる。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、後藤らのレーザ構造では、可飽和吸収層が活性層の片方の側だけにしか設けられておらず、かつ、その活性層からの距離が大きく(少なくとも $250\mu m$)設定されている。

(3)

3

ここで、活性層から可飽和吸収層までの距離を大きくしなければならないのは、電流ブロック層3が、 $p-n-p-n$ 構造によって電流をブロックできるようにするためには、クラッド層6の膜厚を一定以上に厚くしなければならないからである。従来例では、活性層から可飽和吸収層までの距離が大きいため、可飽和吸収層の導入に伴って活性層の閉じ込め係数が大きく低下する、集光ビーム形状が歪む、という問題が起り、なお改善すべき課題が残されていた。

【0009】本発明はこの点に鑑みてなされたものであって、その目的は、活性層の光閉じ込め係数が可飽和吸収層からの影響を受けにくくして、設計をしやすくし、また、集光ビームの形状を良好なものとして、光ディスク上からの読み取りをよりノイズの少ないものとすることができるようにすることである。

【0010】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明によれば、第1導電型の半導体基板(111)上に第1導電型の第1のクラッド層(110)、第1導電型の可飽和吸収層(109)、第1導電型の第2のクラッド層(108)、活性層(107)、第2導電型の第1のクラッド層(106)、第2導電型の可飽和吸収層(105)、第2導電型の第2のクラッド層(104)、第2導電型のコンタクト層(102)がこの順に形成されていることを特徴とする半導体レーザ、が提供される。

【0011】また、本発明によれば、第1導電型の半導体基板(211)上に第1導電型のクラッド層(208)、活性層(207)、第2導電型の第1のクラッド層(206)、第2導電型の可飽和吸収層(205)、断面形状が“凸”字状である第2導電型の第2のクラッド層(204)、第2導電型のコンタクト層(202)がこの順に形成され、前記第2導電型の第2のクラッド層の凸起部が第1導電型の電流ブロック層(203)に囲まれていることを特徴とする半導体レーザ、提供される。

【0012】そして、好ましくは、前記第1導電型の第2のクラッド層(108)および前記第2導電型の第1のクラッド層(106)、または、前記第2導電型の第1のクラッド層(206)の膜厚は200nm以下になる。

【0013】

【作用】図1(a)～(c)は、本発明の作用を説明するための半導体レーザの断面図であり、これらと対比するために、従来例の構造が図1(d)に示されている。図1(a)～(c)に示される本願発明の半導体レーザの従来例と相違している点は、
① 基板側のクラッド層内にも、すなわちクラッド層10とクラッド層8との間に可飽和吸収層9が形成されている、

(3)

4

② 活性層と可飽和吸収層との間に挟まれたクラッド層の膜厚が200nm以下である〔図1(a)、(b)では100nm、図1(c)では200nm、これに対して図1(d)の従来例では、250nm以上〕、そして、その結果として、

③ 可飽和吸収層の膜厚が薄くなされている、ことである〔但し、以下の図2、図3では、図1(d)の従来例について、可飽和吸収層と活性層の距離LSAを200nmとした場合でのデータが示されている〕。

【0014】まず、可飽和吸収層厚さの設計について述べる。可飽和吸収層がパルセーションを誘発するためには可飽和吸収層が一定以上の光を閉じ込める必要がある。図示された構造の半導体レーザにおいて、パルセーションを誘発するに必要な可飽和吸収層の光閉じ込め係数 Γ_{SA} は、 $\Gamma_{SA}=0.05$ である。図2に、可飽和吸収層の光閉じ込め係数(Γ_{SA})と可飽和吸収層の厚さ(d_{SA})の関係を示す。従来の後藤らの報告のように可飽和吸収層と活性層の距離(LSA)が250nm以上と遠く、かつ、可飽和吸収層が片側のクラッド層にしかない場合には、厚い可飽和吸収層が必要となる。仮に、 LSA を200nmと近付けたとしても〔図1(d)〕、40nmとかなり厚い可飽和吸収層が必要である。

【0015】これに対し、可飽和吸収層が両側のクラッド層にある場合〔図1(c)〕、必要な可飽和吸収層の厚さは30nmに低減する。さらに、可飽和吸収層を活性層に近づけて $LSA=100\text{nm}$ とすると〔図1(a)、(b)〕、必要な可飽和吸収層の厚さは20nmまで低減する。

【0016】後藤らのレーザ構造では、電流ブロックの機能を発揮するために可飽和吸収層の膜厚を250nm以上とする必要があったが、本発明の図1(a)の例〔あるいは第2の実施例〕によれば、この制限がなくなるため、 $LSA \leq 200\text{nm}$ 、例えば $LSA=100\text{nm}$ とすることが可能になり、その結果からも、可飽和吸収層の厚さ(d_{SA})を薄くすることが実現されている。

【0017】図3は、 LSA をパラメータとした、可飽和吸収層の閉じ込め係数 Γ_{SA} と活性層の閉じ込め係数 Γ_{ACT} との関係を示すグラフである。同図に示されるように、 LSA が小さくなるほど活性層の閉じ込め係数 Γ_{ACT} が可飽和吸収層の閉じ込め係数 Γ_{SA} の影響を受けにくくなる。したがって、 LSA が小さくなるほど半導体レーザの設計が容易になる。

【0018】図4は、 LSA をパラメータとした、可飽和吸収層の閉じ込め係数 Γ_{SA} と活性層に直交する方向のスポットサイズ(d_{ACT}/Γ_{ACT})との関係を示すグラフである〔但し、 d_{ACT} は活性層の厚さ〕。同図から分かるように、活性層に直交する方向のスポットサイズも、 LSA が小さくなるほど可飽和吸収層を設けたことによる影響を受けにくくなる。

【0019】図5は、図1(a)、(b)に示した本発

(4)

5

明の半導体レーザの近視野像と屈折率プロファイルであり、図6は、図1(c)に示した本発明の半導体レーザの近視野像と屈折率プロファイルである。また、図7は、図1(d)に示した従来の半導体レーザの近視野像と屈折率プロファイルである。本発明の半導体レーザの近視野像は、従来例のそれに比較して、歪みが少なくなっている。これは、可飽和吸収層を活性層の両側に対称に設けたためと、可飽和吸収層を活性層に近づけたためである。

【0020】

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

【第1の実施例】図8は、本発明の第1の実施例を示す断面図である。この半導体レーザは次のように作製された。まず、n型GaAs基板211の上に、Siドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるn型AlGaInPクラッド層110を1.0μmの膜厚に、Siドープの(A_{1.0.1}Ga_{0.9})_{0.5}In_{0.5}Pからなるn型AlGaInP可飽和吸収層109を20nmの膜厚に、Siドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるn型AlGaInPクラッド層108を100nmの膜厚に、ノンドープの(A_{1.0.1}Ga_{0.9})_{0.5}In_{0.5}PからなるAlGaInP活性層107を40nmの膜厚に、Znドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるp型AlGaInPクラッド層106を100nmの膜厚に、Znドープの(A_{1.0.1}Ga_{0.9})_{0.5}In_{0.5}Pからなるp型AlGaInP可飽和吸収層105を20nmの膜厚に、Znドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるp型AlGaInPクラッド層104を1.0μmの膜厚に、それぞれ有機金属気相成長法(Metalorganic Vapor Phase Epitaxy: MOVPE法)により順次成長させた。結晶成長条件は、成長温度：700～850°C、V/IIIガス流量比：30～1500、とした。

【0021】結晶成長の後、CVD法によりシリコン酸化膜を堆積しこれをストライプ状に加工する。そして、このシリコン酸化膜をマスクとしてクラッド層104の一部を選択的にエッチング除去し、底部の幅が5μm程度のストライプ状のリッジを形成する。上記のシリコン酸化膜を再びマスクとして用いて、n型GaAs電流ブロック層103を選択的に成長させた。選択成長後、マスクとしてもちいたシリコン酸化膜を除去し、電流ブロック層103とクラッド層104の表面にp型GaAsコンタクト層102を成長させた。

【0022】さらに、p型GaAsコンタクト層102にオーミック接触するp側電極201と、n型GaAs基板211にオーミック接触するn側電極212を形成し、レーザ端面を形成する。最後に、レーザ端面に誘電体膜によるコーティングを施して、本実施例の半導体レーザの製作を完了する。

(4)

6

【0023】【第2の実施例】図9は、本発明の第2の実施例を示す断面図である。この半導体レーザは次のように作製された。まず、n型GaAs基板211の上に、Siドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるn型AlGaInPクラッド層208を1.0μmの膜厚に、ノンドープの(A_{1.0.1}Ga_{0.9})_{0.5}In_{0.5}PからなるAlGaInP活性層207を40nmの膜厚に、Znドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるp型AlGaInPクラッド層206を100nmの膜厚に、Znドープの(A_{1.0.1}Ga_{0.9})_{0.5}In_{0.5}Pからなるp型AlGaInP可飽和吸収層205を20nmの膜厚に、Znドープの(A_{1.0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}Pからなるp型AlGaInPクラッド層204を1.0μmの膜厚に、それぞれ有機金属気相成長法により順次成長させた。結晶成長条件は、第1の実施例の場合と同様である。

【0024】結晶成長の後、CVD法によりシリコン酸化膜を堆積しこれをストライプ状に加工する。そして、このシリコン酸化膜をマスクとしてクラッド層204の一部を選択的にエッチング除去し、底部の幅が5μm程度のストライプ状のリッジを形成する。上記のシリコン酸化膜を再びマスクとして用いて、n型GaAs電流ブロック層203を選択的に成長させた。選択成長後、マスクとしてもちいたシリコン酸化膜を除去し、電流ブロック層203とクラッド層204の表面にp型GaAsコンタクト層202を成長させた。

【0025】さらに、p型GaAsコンタクト層202にオーミック接触するp側電極201と、n型GaAs基板211にオーミック接触するn側電極212を形成し、レーザ端面を形成する。最後に、レーザ端面に誘電体膜によるコーティング(図示なし)を施して、本実施例の半導体レーザの製作を完了する。

【0026】【実施例の変更】以上本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれら実施例に限定されるものではなく特許請求の範囲に記載された範囲内において各種の変更が可能である。例えば、実施例ではn型半導体基板を用いる場合について説明したが、p型半導体基板を用いても同様の効果を得ることが可能である。この場合、上述の実施例の中での導電型をすべて逆にすればよい。また、基板としてはGaAsの代わりにGaAsP基板を用いてもよい。

【0027】さらに、結晶成長させる半導体層としてはAlGaInPの代わりにAlGaNPsを用いてもよい。また、実施例では、n型ドーパントとしてSiを、p型ドーパントとしてZnを用いる例について説明したが、これらのドーパントに代え、n型ドーパントとしてSeなどの、p型ドーパントとしてMg、Beなどの他のドーパントを用いてもよい。

【0028】また、結晶成長法はMOVPE法に限らず分子線成長法(MBE法)、有機金属分子線成長法(M

(5)

7

OMB法)、ガスソース分子線成長法(GSMBE法)などを用いることも可能である。

【0029】活性層に引っ張り歪みや圧縮歪の歪QWを採用してもよく、その場合、発振閾値等のレーザ特性の改善が期待できる。あるいは、可飽和吸収層に歪QWを採用してもよい。適切な格子歪を導入することにより可飽和吸収層の微分利得を増大させることができる。可飽和吸収層微分利得が大きいとパルセーション発生に必要な可飽和吸収層光吸収量が低減するので、上記の変更はレーザ特性を改善する上で望ましい。

【0030】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の半導体レーザは、活性層と可飽和吸収層との距離を短くし、さらに、活性層の両側に可飽和吸収層を設けるようにしたものであるので、活性層の閉じ込め係数やスポットサイズが可飽和吸収層の設計の影響を受けにくくなり、レーザの特性分析や最適化設計が容易になる。また、レーザビーム形状の歪みを少なくすることができるので、光ディスク上に良質な形状の集光スポットを形成することができる。

【0031】さらに、必要な可飽和吸収層の厚さを薄くすることができるため、歪QW活性層と同様な大きな格子歪を導入することができる。これにより、可飽和吸収層のバンドギャップエネルギー、吸収スペクトル形状、微分利得、等を自由に制御することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の作用を説明するための半導体レーザの断面図〔(a)～(c)〕は本発明の半導体レーザの構造を示し、(d)は従来例の構造を示す〕。

【図2】活性層から可飽和吸収層までの距離をパラメータとした、可飽和吸収層の閉じ込め係数と可飽和吸収層の膜厚との関係を示すグラフ。

【図3】活性層から可飽和吸収層までの距離をパラメータとした、可飽和吸収層の閉じ込め係数と活性層の閉じ込め係数との関係を示すグラフ。

(5)

8

【図4】活性層から可飽和吸収層までの距離をパラメータとした、可飽和吸収層の閉じ込め係数とスポットサイズとの関係を示すグラフ。

【図5】図1(a)、(b)に示した半導体レーザの半導体層の屈折率プロファイルと光強度プロファイル。

【図6】図1(c)に示した半導体レーザの半導体層の屈折率プロファイルと光強度プロファイル。

【図7】図1(d)に示した半導体レーザの半導体層の屈折率プロファイルと光強度プロファイル。

【図8】本発明の第1の実施例の半導体レーザの断面図。

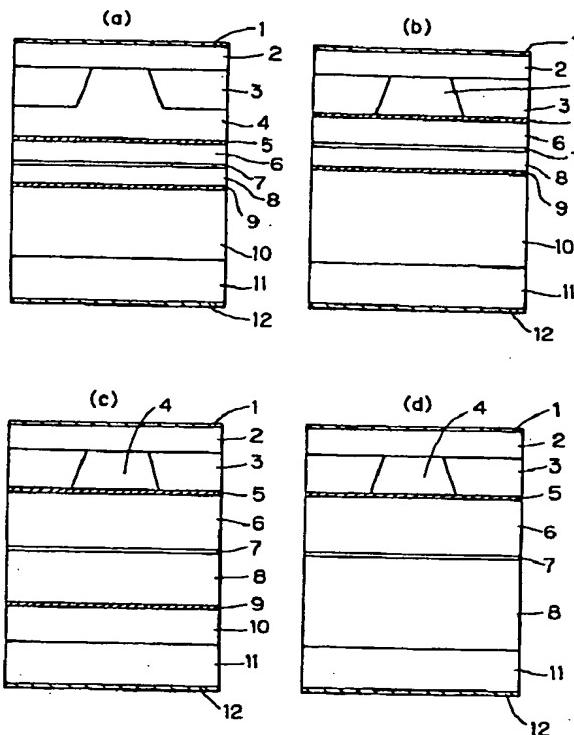
【図9】本発明の第2の実施例の半導体レーザの断面図。

【符号の説明】

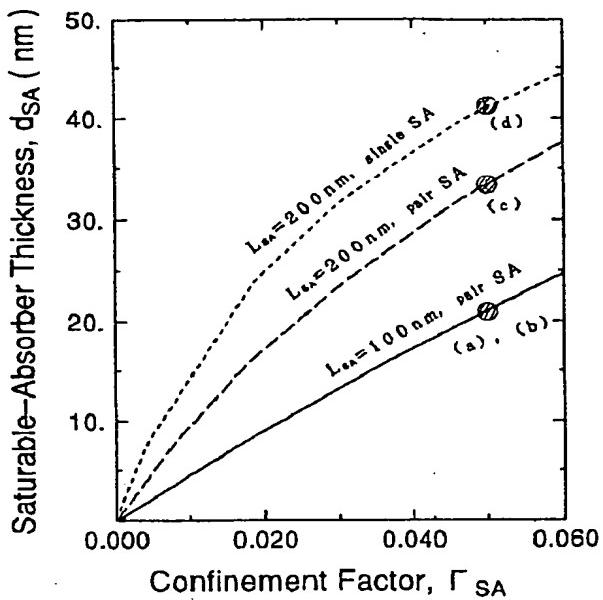
- 1 第1電極
- 2 コンタクト層
- 3 電流ブロック層
- 4、6、8、10 クラッド層
- 5、9 可飽和吸収層
- 20 7 活性層
 - 11 半導体基板
 - 12 第2電極
 - 101、201 p側電極
 - 102、202 p型GaAsコンタクト層
 - 103、203 n型GaAs電流ブロック層
 - 104、204、106、206 p型AlGaInPクラッド層
 - 105、205 p型AlGaInP可飽和吸収層
 - 107、207 AlGaInP活性層
 - 30 108、208、110 n型AlGaInPクラッド層
 - 109 n型AlGaInP可飽和吸収層
 - 111、211 n型GaAs基板
 - 112、212 n側電極

(6)

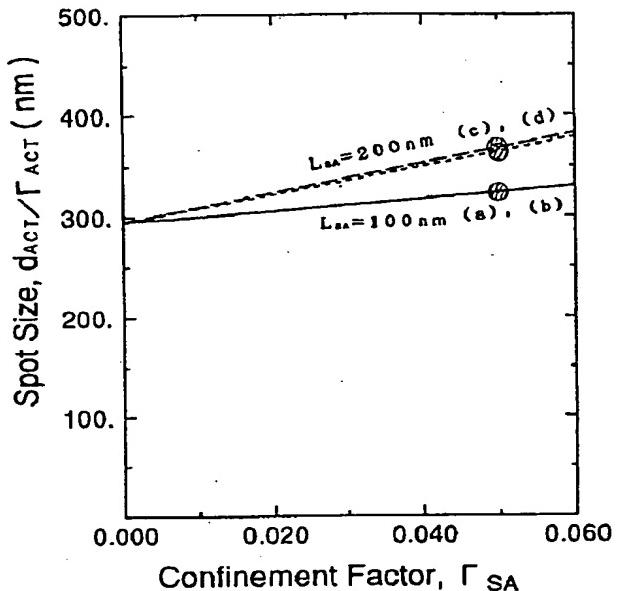
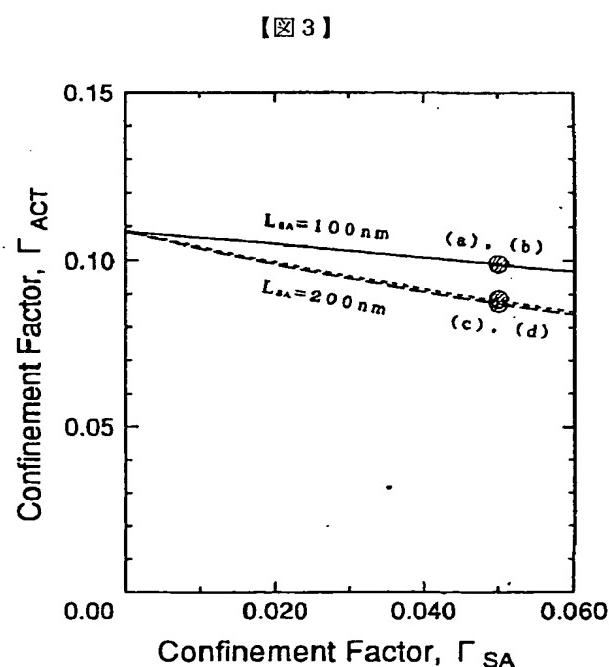
【図1】



【図2】

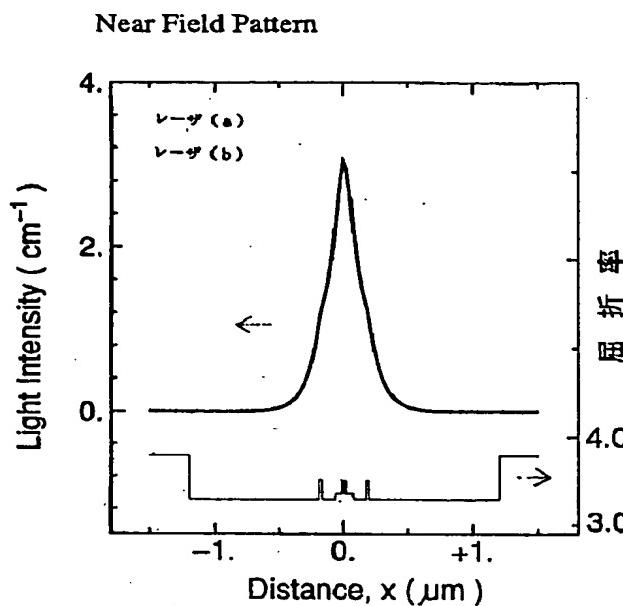


【図4】

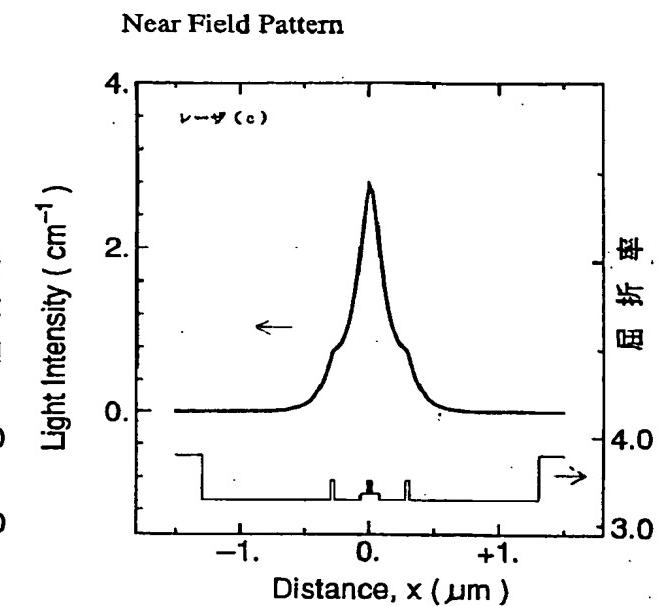


(7)

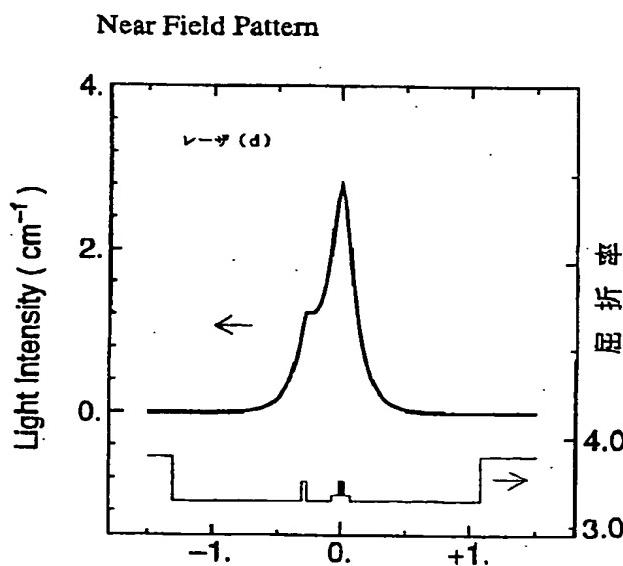
【図5】



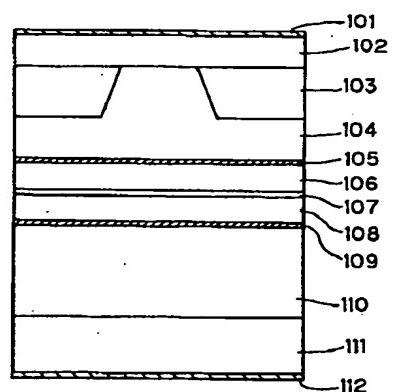
【図6】



【図7】

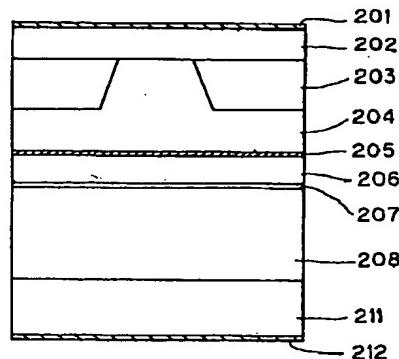


【図8】



(8)

【図9】



- 201…p側電極
202…p型GaAsコンタクト層
203…n型GaAs電流ブロック層
204…p型AlGaInPクラッド層
205…p型AlGaInP可飽和吸収層
206…p型AlGaInPクラッド層
207…AlGaInP活性層
208…n型AlGaInPクラッド層
211…n型GaAs基板
212…n側電極